

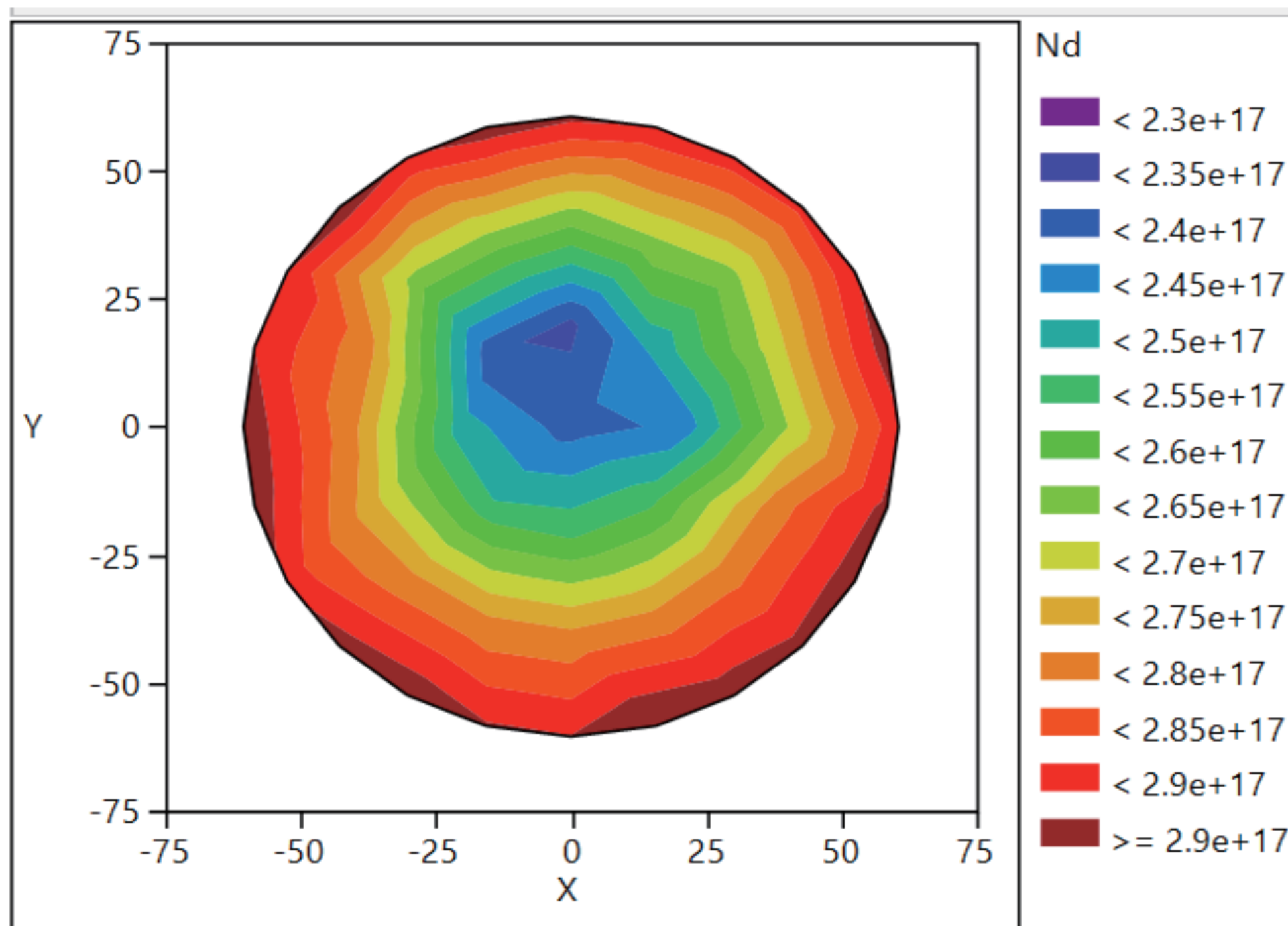
シリコンウェハーや化合物半導体SiCの汚染評価・検査用途で、半導体業界で幅広く使用されています。非接触・非破壊式の重金属汚染・CV/IV・膜評価・検査装置です。

特徴

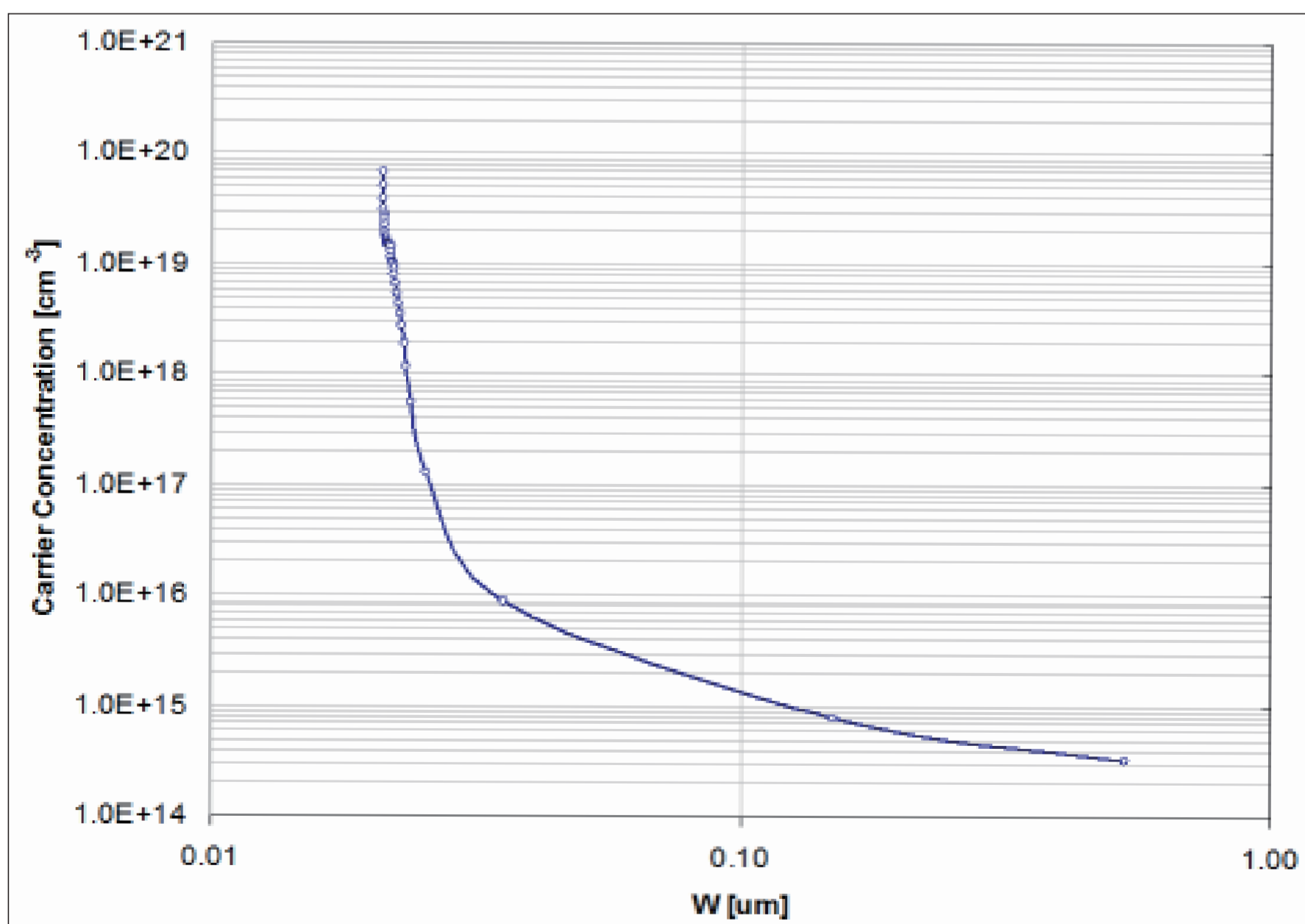
- ▶ 表面ドーパ濃度 マッピング測定
- ▶ 深さ方向ドーパ濃度 プロファイリング
- ▶ 品質評価 (電荷漏れ評価)
- ▶ 絶縁膜のCV測定

※ 上記測定は、シリコン上の絶縁膜CV測定も可能です。

測定イメージ



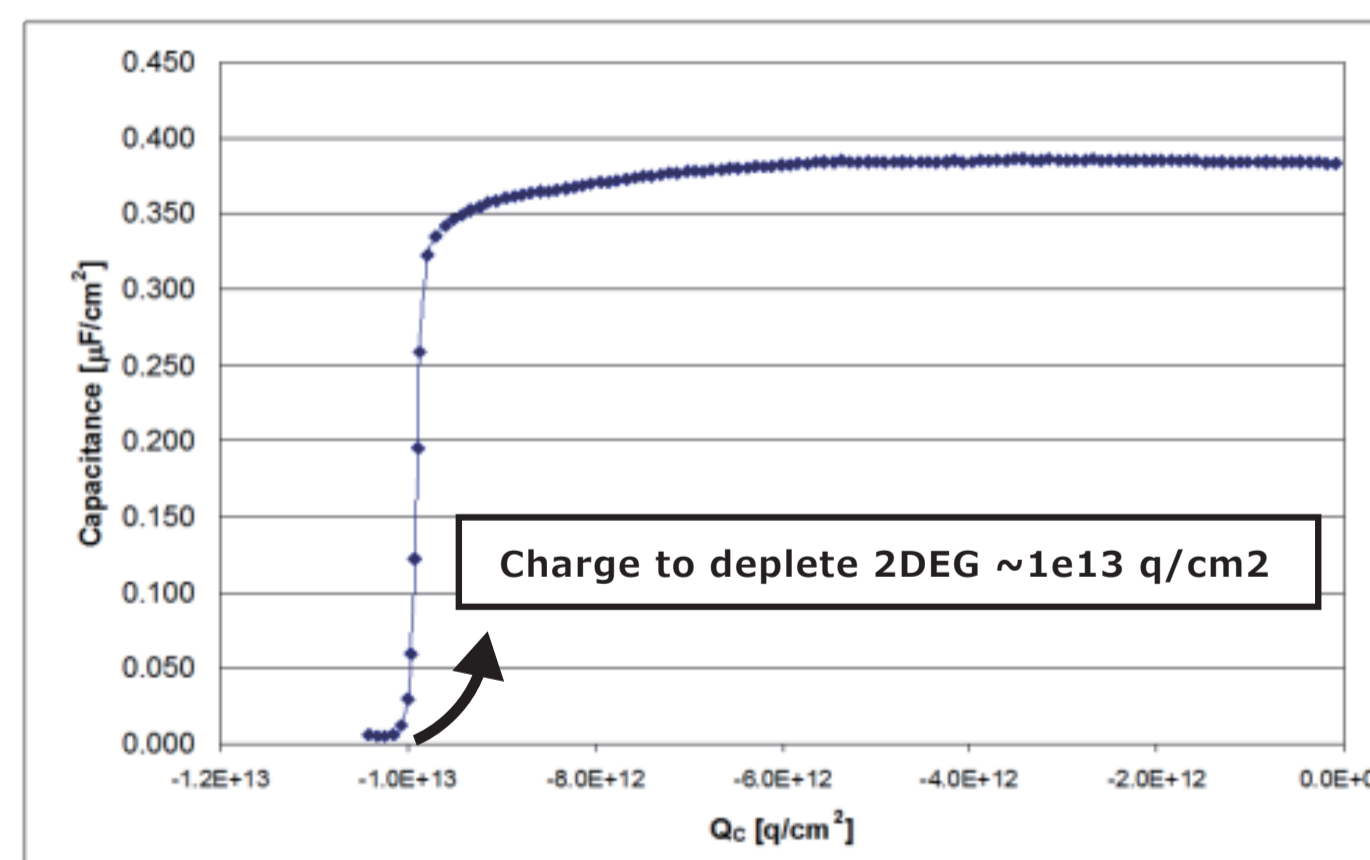
表面ドーパ濃度マッピング



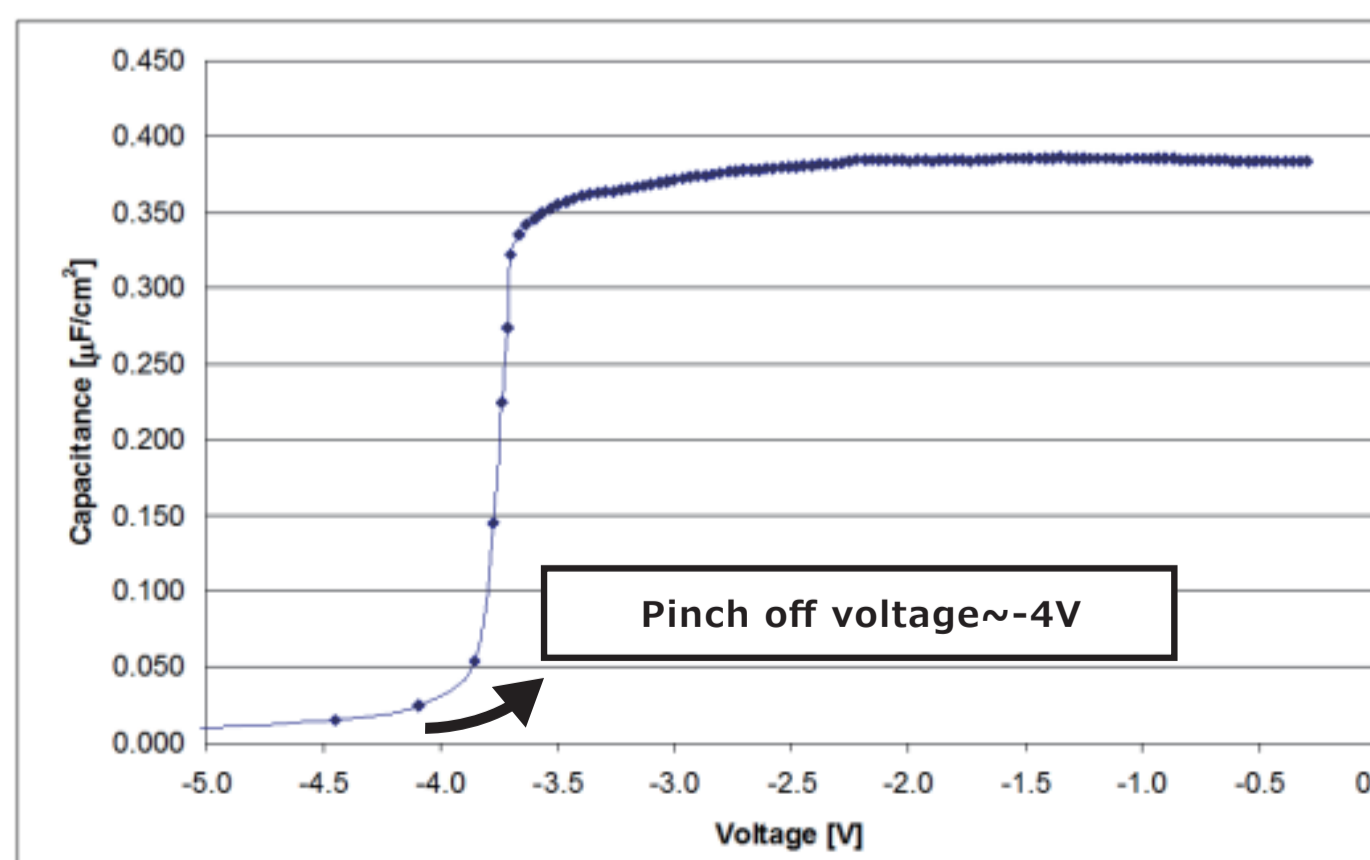
深さ方向ドーパ濃度プロファイリング



FAaST-210
(マニュアル搬送 200mm)



2DEG Sheet Charge



Pinch Off 電圧